

法政大学イオンビーム工学研究所報告
No. 36. 2015年度 目次

(出版者 / Publisher)

法政大学イオンビーム工学研究所

(雑誌名 / Journal or Publication Title)

Report of Research Center of Ion Beam Technology, Hosei University / 法政
大学イオンビーム工学研究所報告

(巻 / Volume)

36

(発行年 / Year)

2017-02-15

法政大学イオンビーム工学研究所報告

No. 36 2015

目 次

巻 頭 言	山本 康博 (1)
1. 研究ノート	
1. 高耐圧GaN縦型pn接合ダイオードの研究 太田 博、中村 徹、三島 友義 (3)	
2. プロトン照射GaNにおける誘起欠陥 ―弾性反跳分析・熱刺激電流法による評価― 西片 直樹、中村 司、上岡 一馬 栗山 一男、串田 一雅、徐 虬 (12)	
3. SiGeにおけるイオンビーム誘起界面非晶質化 柏木 俊秀、飯塚 健太、石濱 佑亮、山本 康博 (16)	
2. 第34回法政大学イオンビーム工学研究所シンポジウム	(27)
3. 年間事業報告	西村 智朗 (33)
4. 研究の現状	(34)
5. 研究成果発表論文リスト	(36)
6. 研究所組織	(46)
編集後記	(47)